

## Энтропия

В классической термодинамике энтропию рассматривают как координату состояния, соответствующую теплообмену. Основание: сохранение энтропии в обратимых процессах  $dS = 0$  и аналогия выражений  $dQ = TdS$  и обобщенной работы  $dA_k = P_k dx_k$ . Но энтропия отличается от таких координат состояния, как объем, масс, заряд. В общем случае для нее не выполняется закон сохранения. В замкнутых системах с постоянными объемом и энергией энтропия только растет  $(dS)_{U,V} \geq 0$  и в равновесии она максимальна; энтропия минимальна при минимуме соответствующей ей обобщенной силы:  $S(T) \rightarrow 0$  при  $T \rightarrow 0$ .

В статистике энтропию вычисляют по уравнению, данному выше, которое можно записать в следующем виде:

$$S = \frac{U - U_0}{T} + k \ln Z = k \ln \sum \Omega_k e^{-\frac{E_k}{kT}} + \frac{U - U_0}{T}$$
 Здесь определения:  $\Omega_k$  - число состояний системы, имеющих энергию  $E_k$ ,  $U - U_0$  - средний избыток энергии системы при температуре  $T$  по сравнению с энергией при  $T = 0$ . Член  $(U - U_0)/T \rightarrow 0$ , а экспонента  $\rightarrow 1$  при  $T \rightarrow 0$ , т.е. при  $T \rightarrow 0$   $S \rightarrow k \ln Z = k \ln(g_0)$  и если основное состояние невырождено (идеальный кристалл) получаем, что при  $T \rightarrow 0$   $S \rightarrow 0$ . III закон термодинамики.

по Васильеву, с.119.

Из уравнения Гиббса-Гельмгольца  $S = (U-F)/T$ . Но очевидны соотношения

$$U = \int \epsilon e^{(F-\epsilon)/kT} d\Gamma \text{ и } F = \int F e^{(F-\epsilon)/kT} d\Gamma, \text{ т.е. } S = -k \frac{F - \langle \epsilon \rangle}{kT} = -k \int \frac{F - \epsilon}{kT} e^{(F-\epsilon)/kT} d\Gamma.$$

Функция  $w = e^{(F-\epsilon)/kT}$  - плотность вероятности распределения Гиббса и  $S = -k \int w \ln w d\Gamma = -k \langle \ln w \rangle$ .

### Отрицательные температуры.

Рассмотрим систему с постоянным числом  $N$  независимых частиц. Каждая частица может находиться в двух состояниях: с безразмерной энергией 0 или  $\epsilon$ . Частицы находятся в тепловом контакте с резервуаром, имеющим температуру  $t = kT$ . Статистическая сумма при двух состояниях будет равна  $Z = 1 + \exp(-\epsilon/t)$ . Средняя энергия одной частицы определяется через связь  $u$  и  $Z$  или по формуле поскольку  $g = 1$ .

$$u = \langle \epsilon \rangle = \tau^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial \tau} \text{ и } \langle \epsilon \rangle = \frac{0 \cdot 1 + \epsilon \cdot \exp(-\epsilon/\tau)}{Z} = \epsilon \frac{\exp(-\epsilon/\tau)}{1 + \exp(-\epsilon/\tau)} = \frac{\epsilon}{1 + \exp(\epsilon/\tau)}$$

Средняя энергия системы  $U$  получается умножением на  $N$ . Теплоемкость системы равна производной  $U$  по  $T$  при постоянном объеме.

$$C_v = \frac{dU}{dT} = Nk \frac{\epsilon^2}{\tau^2} \frac{\exp(\epsilon/\tau)}{\exp(\epsilon/\tau) + 1} \text{ Здесь } T = \tau/k.$$

В пределе высоких температур теплоемкость пропорциональна квадрату отношения

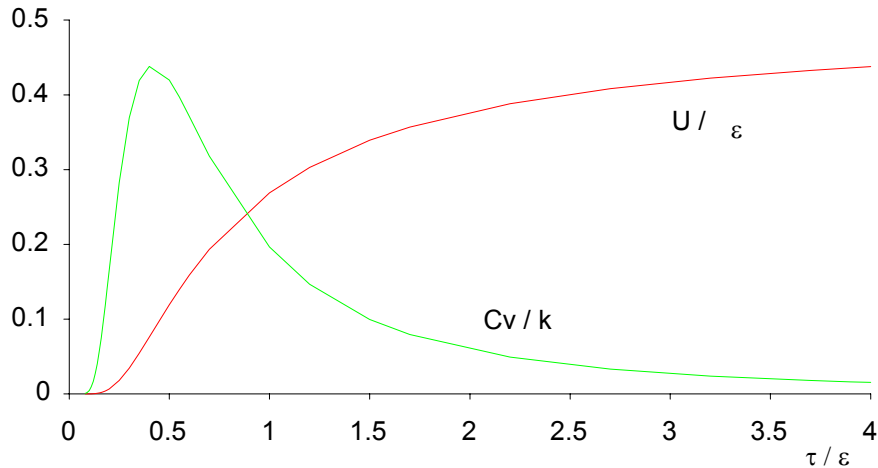
энергия/температура. (значение экспоненты стремится к 1).  $C_v = \frac{1}{4} Nk \left(\frac{\epsilon}{\tau}\right)^2$ . При

низких температурах преобразуем член, содержащий экспоненты, и его величина примерно равна  $\exp(-\epsilon/t)$ , т.е. будет зависимость от квадрата отношения и  $\exp(-\epsilon/t)$ : быстрое падение  $C_v$  с уменьшением температуры. Для преобразования умножим и разделим на экспоненту со знаком минус, а экспоненту со знаком плюс перенесем в знаменатель.

$$\frac{\exp(\varepsilon / \tau)}{[1 + \exp(\varepsilon / \tau)]^2} = \frac{\exp(-\varepsilon / \tau)}{\exp(-\varepsilon / \tau)[\exp(-\varepsilon / \tau) + 2 + \exp(\varepsilon / \tau)]} = \frac{\exp(-\varepsilon / \tau)}{1 + 2\exp(-\varepsilon / \tau) + \exp(-2\varepsilon / \tau)}$$

и при малых  $t$  знаменатель стремится к 1.

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,T} = Nk \left(\frac{\varepsilon}{\tau}\right)^2 \exp(-\varepsilon / \tau) \text{ при } \tau \rightarrow 0.$$



Моделирование проведено для одной частицы. Отметим максимум на теплоемкости. Этот эффект используют при изучении распределения уровней энергии твердого тела. Такой эффект - аномалии Шоттки.

Определим теперь безразмерную энтропию. По определению

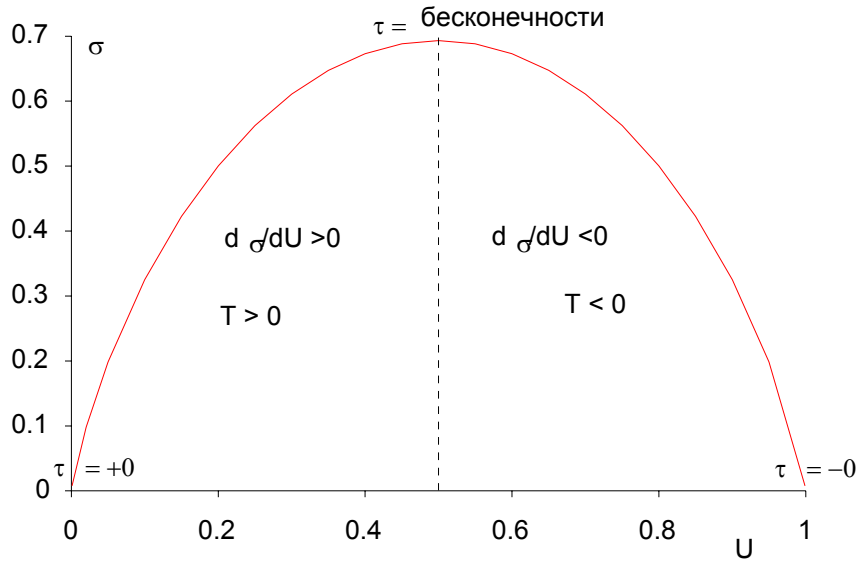
$$\frac{1}{\tau} = \frac{\partial \sigma}{\partial U} \text{ и } \sigma = \sum_0^U \frac{U}{\tau}. \text{ Используем } \frac{\varepsilon}{\tau} = \ln \frac{N\varepsilon}{U} - 1 = \ln(N\varepsilon - U) - \ln U.$$

Здесь было использовано полученное ранее выражение  $u = \frac{\varepsilon}{1 + \exp(\varepsilon / \tau)}$ . После инте-

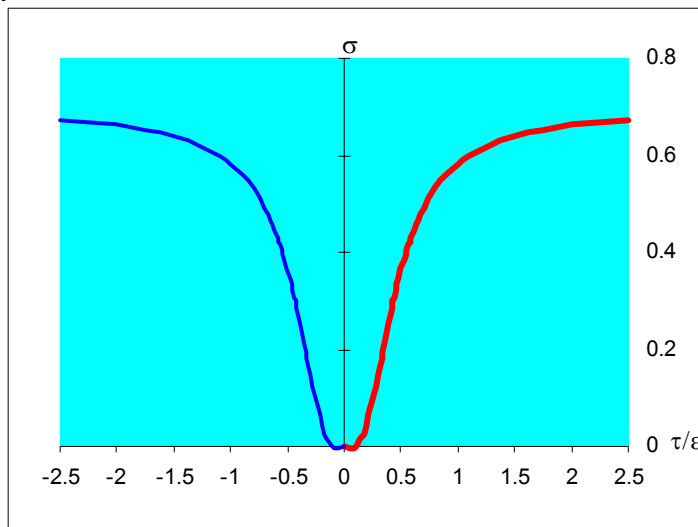
грирования получим выражение для безразмерной энтропии

$$\sigma = \frac{1}{\varepsilon} [N\varepsilon \ln(N\varepsilon) - U \ln U - (N\varepsilon - U) \ln(N\varepsilon - U)].$$

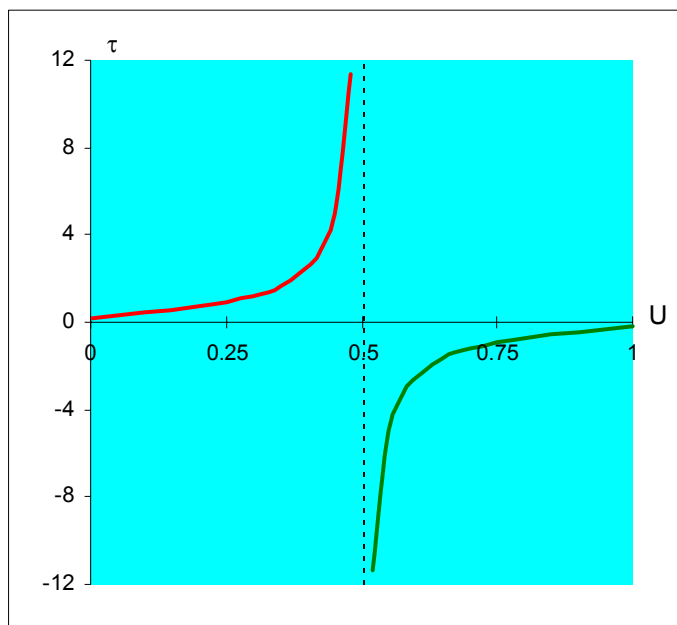
Ниже приведен результат моделирования при  $N = 1$  и  $e = 1$ .



Максимум функции при  $U = 0,5$ . Слева от пунктира производная  $(ds / dU)_N = t$  положительна, т.е. положительна температура. В максимуме температура бесконечна, а справа температура будет отрицательной. Интересно, что от положительной к отрицательной температуре приходим через  $\Gamma$ , т.к.  $t = 1 / \ln[(1-U)/U]$ . Энергия максимальна не при  $t = +\Gamma$ , а при  $t = -0$ .



Рассмотрим зависимость безразмерной энтропии от величины  $t / \epsilon$  в области положительных температур. Точка перегиба лежит в области максимума на кривой теплоемкости, а в пределе больших температур  $s$  стремится к  $N \ln 2$ , т.е. все состояния допустимы.



Смысл отрицательной температуры заключается в том, что в этой области энергий заселенность верхнего уровня энергии выше заселенности нижнего:

$P_{\text{верх}} / P_{\text{нижн}} = \exp(- e/ t )$  - инверсная заселенность.

Физически это требует предела верхнего энергетического состояния.

Поступательная и колебательная составляющая энергии такого предела не имеют.

Чаще такая картина рассматривается для направленности ядерного или электронного спина (например, LiF, Li и F имеют разную температуру). При этом обязательно тепловое равновесие. Отрицательные температуры соответствуют более высоким энергиям. При контакте с системой, имеющей положительную температуру, энергия будет переходить к ней. Опыты проводят в установках спинового резонанса. При этом у системы с отрицательной температурой будет резонансное испускание. Используют для усиления слабых сигналов.